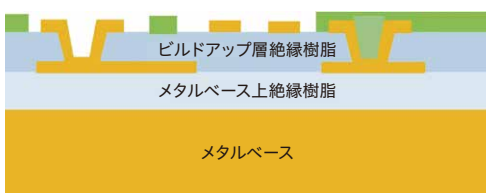


多層メタルベース基板

Multi-Layer Metal base PCB

	複層メタルベース基板	放熱樹脂ビルドアップ基板
構造例		
放熱樹脂	H5T、M2P	ビルドアップ層絶縁層樹脂：H5T、M2P メタルベース上絶縁樹脂：全樹脂対応可
メタルベース	銅 or アルミ	銅
特長	一般的なプロセスで作製した積層基板を放熱樹脂を用いてメタルベースに貼付けて放熱	メタルベース基板上に放熱絶縁樹脂、導体層を積層し、非貫通ビアで層間接続

GaNMO-MS基板 ※GaN Multi-layer Organic Metal Substrate

ワイドバンドギャップ半導体 (GaN、SiC等) に有効な構造

- ソース／ドレインを層間で配線することにより、低インダクタンス化が可能
- キャビティ構造により、低熱抵抗化および低背化が可能

構造図

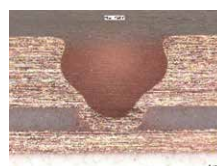


実施例

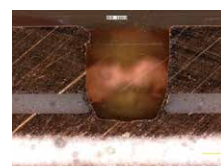


層間接続ビア

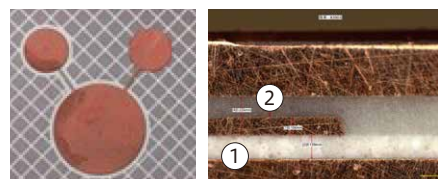
レーザービア



ドリルビア

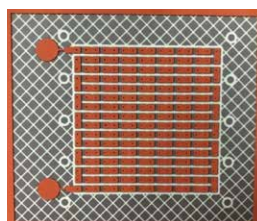


耐電圧



①ベース銅-内層導体間	AC5kV以上
②内層導体-外層導体間	AC5kV以上

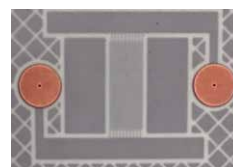
ビア接続信頼性



-50℃⇔150℃ 各30分
2000サイクル
抵抗値変化無し (0.4mΩ/ビア)

イオンマイグレーション

線間 (L/S=0.2mm)



85℃、85%RH、DC100V
1000時間
絶縁抵抗値：1.0E+10Ω以上

層間

